## $Ti_4O_7$ 의 전자상래에 대한 제 1 원리적연구

리문혁, 김경일

이산화티탄(TiO<sub>2</sub>)은 빛촉매, 빛전지, 전자공학을 비롯하여 여러 분야에서 널리 리용된다.[1] 가장 대표적인 응용은 물을 산소와 수소로 분해하는 반응에 대한 빛촉매작용이다.[2] 그러나 TiO<sub>2</sub>에 대하여 실험적으로 측정한 금지띠값은 금홍석형에서는 3.0eV, 예추석형에서는 3.2eV로서 넓은 범위의 태양빛을 효과적으로 리용할수 없다.

보임빛대역에 대한 빛흡수률을 높이기 위하여 금지띠폭을 줄여야 한다. 산소결핍형 이산화티란(아산화티란  $Ti_nO_{2n-x}$ )을 리용하면 금지띠폭을 줄일수 있다. 여기서 n=2인 경우는 강옥형, n>2인 경우는 마그넬리형으로 구분한다. 이 물질들은 금지띠폭이 작은것으로 하여 보임빛대역의 빛을 잘 흡수하는 우점이 있는 반면에 재결합확률이 크고 가전자띠와 전도띠의 에네르기준위가 물의 산화환원전위와 잘 맞지 않는 결함을 가지고있다. 물분해효률을 높이기 위하여 아산화티란에 여러가지 혼입물을 첨가하는 방법들이 제기되고있는데 그중에서 질소혼입형아산화티란을 제일 많이 리용하고있다. 그 리유는 질소원자와 산소원자의 크기가 비슷하고 이온화에네르기가 작으며 안정화시키는 역할을 하기때문이다.

우리는 n=4인 경우 즉  $Ti_4O_7$ 구조와 질소가 혼입된  $Ti_4O_5N_2$ 구조에 대하여 가전자띠로 부터 전도띠에로의 전자이행과정에 대하여 미시론적으로 밝혔다.

론문에서는 Quantum Espresso(version 6.1)[3]를 리용하여 모든 계산을 진행하였다. 계산에서는 교환-상관밀도범함수로서 GGA의 PBE를 리용하였다. Ti의 3d궤도에 대한 U값을 5.44eV(0.4Ry)로 설정하였으며 스핀분극을 고려하지 않았다.

우선 에네르기띠구조계산을 진행하였다. 여기서 비점유궤도수를 20개로, k점경로를  $G \rightarrow F \rightarrow O \rightarrow Z \rightarrow G$ 로 설정하였다.

그림 1에 Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>결정과 Ti<sub>4</sub>O<sub>5</sub>N<sub>2</sub>결정의 에네르기띠구조를 보여주었다.

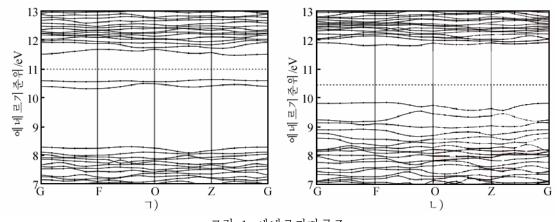


그림 1. 에네르기띠구조 기) Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>결정, L) Ti<sub>4</sub>O<sub>5</sub>N<sub>2</sub>결정

그림 1에서 보는바와 같이  $Ti_4O_7$ 결정에서는 금지띠폭이 0.839eV이며  $Ti_4O_5N_2$ 결정에서는 금지띠폭이 1.972eV이다. 이것은  $TiO_2$ 과는 달리 질소를 첨가하는 경우에 금지띠폭이 더 넓어진다는것을 의미한다.

이것을 밝히기 위하여  $Ti_4O_7$ 결정과  $Ti_4O_5N_2$ 결정의 부분상태밀도(PDOS)해석을 진행하였다.(그림 2)

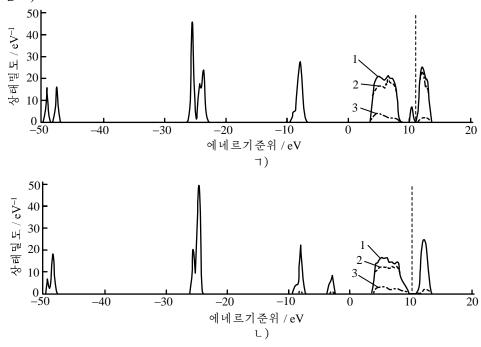


그림 2. 부분상태밀도(PDOS)

ㄱ)  $Ti_4O_7$ 결정, ㄴ)  $Ti_4O_5N_2$ 결정, 1-3은 각각 전체 상태밀도, p, d궤도에서의 상태밀도에 해당됨

그림 2에서 보는바와 같이  $Ti_4O_7$ 결정에서 페르미준위의 량쪽에서는 Ti의 3d궤도가 기본을 이루며  $Ti_4O_5N_2$ 결정에서 페르미준위의 왼쪽에서는 N의 2p궤도가, 오른쪽에서는 Ti의 3d궤도가 기본을 이룬다. 이것은 전자이행이  $Ti_4O_7$ 결정에서는 Ti의 3d궤도로부터 Ti의 3d궤도에로 일어나며  $Ti_4O_5N_2$ 결정에서는 N의 2p궤도로부터 Ti의 3d궤도에로 일어난다는것을 보여준다.

이것을 보다 구체적으로 리해하기 위하여  $Ti_4O_7$ 결정과  $Ti_4O_5N_2$ 결정에서 가전자띠와 전도띠의 전자분포를 보기로 하자.

그림 3에 Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>결정에서 가전자띠와 전도띠에서의 전자분포를 보여주었다.

가전자띠에서의 전자분포는 Ti(I)형에, 전도띠에서의 전자분포는 Ti(II)형에 집중되여있으며 따라서 전자이행은 Ti(I)→Ti(II)에서 일어난다고 볼수 있다.

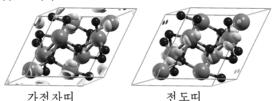


그림 3. Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>결정에서 가전자띠와 전도띠에서의 전자분포

그림 4에 Ti<sub>4</sub>O<sub>5</sub>N<sub>2</sub>결정에서 가전자띠와 전도띠에서의 전자분포를 보여주었다.

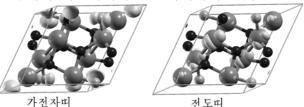


그림 4. Ti<sub>4</sub>O<sub>5</sub>N<sub>2</sub>결정에서 가전자띠와 전도띠에서의 전자분포

전도띠에서의 전자분포는  $Ti_4O_7$ 에서와 같이 Ti(II)형에 집중되여있지만 가전자띠에서의 전자분포는 N원자들에 집중되여있다. 이것은 전자이행이  $N \rightarrow Ti(II)$ 에서 일어난다는것을 의미한다.

## 맺 는 말

- 1) TiO<sub>2</sub>에서와는 달리 Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>에서는 질소를 첨가하면 금지띠폭이 넓어진다.
- 2) Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>에서 전자이행은 Ti의 3d궤도로부터 Ti의 3d궤도에로 일어난다.
- 3)  $Ti_4O_5N_2$ 에서 전자이행은 N의 2p궤도로부터 Ti의 3d궤도에로 일어난다.

## 참고문 헌

- [1] K. Nakata et al.; Electrochim. Acta, 84, 103, 2012.
- [2] S. S. Mao et al.; Nature Photonics, 7, 944, 2013.
- [3] P. Giannozzi et al.; J. Phys: Condens. Matter, 21, 399502, 2009.

주체108(2019)년 6월 5일 원고접수

## Ab Initio Study of the Electronic Structure of Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>

Ri Mun Hyok, Kim Kyong Il

By using ab initio method, we obtained the band structure, PDOS(partial density of states) and the distribution of electrons in valence and conduction bands of  $Ti_4O_7$  and  $Ti_4O_5N_2$  structures, which shows that for  $Ti_4O_7$ , electronic transition occurs between 3d orbitals of Ti atoms, and for  $Ti_4O_5N_2$ , between 2p orbital of N atom and 3d orbital of Ti atom.

Key words: Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, ab initio, band gap